

ZXMP3F30FH 30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

Summary

| $V_{(BR)DSS}$ (V) | $R_{DS(on)}$ (Ω) | I_D (A) |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| -30 | 0.080 @ $V_{GS} = -10V$ | -4.0 |
| | 0.140 @ $V_{GS} = -4.5V$ | |

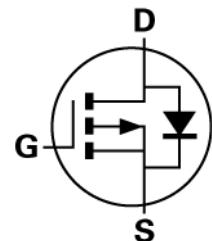


Description

This new generation Trench MOSFET from TY has been designed to minimize the on-state resistance ($R_{DS(on)}$) and yet maintain superior switching performance.

Features

- Low on-resistance
- Fast switching speed
- 4.5V gate drive capability
- Thermally enhanced SOT23 package

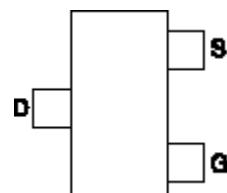


Applications

- Power management
- Portable Equipment
- Battery charging

Ordering information

| Device | Reel size (inches) | Tape width (mm) | Quantity per reel |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| ZXMP3F30FHTA | 7" | 8mm | 3,000 |



Device marking

Pinout – top view

KPA

**ZXMP3F30FH****Absolute Maximum Ratings****Absolute maximum ratings**

| Parameter | Symbol | Limit | Unit |
|---|----------------|------------------------------|------------|
| Drain-Source voltage | V_{DSS} | -30 | V |
| Gate-Source voltage | V_{GS} | ± 20 | V |
| Continuous Drain current @ $V_{GS} = -10V$; $T_A = 25^\circ C$ (b) @ $V_{GS} = -10V$; $T_A = 70^\circ C$ (b) @ $V_{GS} = -10V$; $T_A = 25^\circ C$ (a) @ $V_{GS} = -10V$; $T_L = 25^\circ C$ (d) | I_D | -3.4 -2.7 -2.8 -4.0 | V |
| Pulsed Drain current (c) | I_{DM} | -15.3 | A |
| Continuous Source current (Body diode) (b) | I_S | -2 | A |
| Pulsed Source current (Body diode) (c) | I_{SM} | -15.3 | A |
| Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (a) Linear derating factor | P_D | 0.95 7.6 | W mW/°C |
| Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (b) Linear derating factor | P_D | 1.4 11.2 | W mW/°C |
| Power dissipation at $T_L = 25^\circ C$ (d) Linear derating factor | P_D | 1.96 15.7 | W mW/°C |
| Operating and storage temperature range | T_J, T_{stg} | -55 to 150 | °C |

Thermal resistance

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|-------------------------|-----------------|-------|------|
| Junction to ambient (a) | $R_{\theta JA}$ | 131 | °C/W |
| Junction to ambient (b) | $R_{\theta JA}$ | 89 | °C/W |
| Junction to lead (d) | $R_{\theta JL}$ | 63.77 | °C/W |

NOTES:

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
- (b) Mounted on FR4 PCB measured at $t \leq 10$ sec.
- (c) Repetitive rating on 25mm x 25mm FR4 PCB, $D=0.02$, pulse width 300us – pulse width limited by maximum junction temperature.
- (d) Thermal resistance from junction to solder-point (at the end of the drain lead).

**ZXMP3F30FH****Electrical characteristics (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated)**

| Parameter | Symb ol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
|---|---------------|------|-------|----------------|----------|--|
| Static | | | | | | |
| Drain-Source breakdown voltage | $V_{(BR)DSS}$ | -30 | | | V | $I_D = -250\mu A, V_{GS}=0V$ |
| Zero Gate voltage Drain current | I_{DSS} | | | -1.0 | μA | $V_{DS}=-30V, V_{GS}=0V$ |
| Gate-Body leakage | I_{GSS} | | | 100 | nA | $V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$ |
| Gate-Source threshold voltage | $V_{GS(th)}$ | -1.0 | | | V | $I_D = -250\mu A, V_{DS}=V_{GS}$ |
| Static Drain-Source on-state resistance (*) | $R_{DS(on)}$ | | | 0.080 0.140 | Ω | $V_{GS} = -10V, I_D = -2.5A$ $V_{GS} = -4.5V, I_D = -1.9A$ |
| Forward Transconductance (*) (†) | g_{fs} | | 5 | | S | $V_{DS} = -15V, I_D = -3A$ |
| Dynamic (†) | | | | | | |
| Input capacitance | C_{iss} | | 370 | | pF | $V_{DS} = -15V, V_{GS}=0V$ $f=1MHz$ |
| Output capacitance | C_{oss} | | 72 | | pF | |
| Reverse transfer capacitance | C_{rss} | | 38 | | pF | |
| Switching (‡) (†) | | | | | | |
| Turn-on-delay time | $t_{d(on)}$ | | 1.3 | | ns | $V_{DD} = -15V, V_{GS} = -10V$ $I_D = -1A$ $R_G \approx 6.0\Omega$, |
| Rise time | t_r | | 2.6 | | ns | |
| Turn-off delay time | $t_{d(off)}$ | | 49 | | ns | |
| Fall time | t_f | | 22 | | ns | |
| Gate charge | | | | | | |
| Total Gate charge | Q_g | | 7 | | nC | $V_{DS} = -15V, V_{GS} = -10V$ $I_D = -3A$ |
| Gate-Source charge | Q_{gs} | | 1.2 | | nC | |
| Gate-Drain charge | Q_{gd} | | 1.3 | | nC | |
| Source-Drain diode | | | | | | |
| Diode forward voltage (*) | V_{SD} | | -0.80 | -1.2 | V | $I_S = -1.7A, V_{GS}=0V$ |
| Reverse recovery time (‡) | t_{rr} | | 14.6 | | ns | $I_S = -1.5A, dI/dt=100A/\mu s$ |
| Reverse recovery charge (‡) | Q_{rr} | | 9.5 | | nC | |

NOTES:(*) Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu s$; duty cycle $\leq 2\%$.

(†) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.

(‡) For design aid only, not subject to production testing

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru